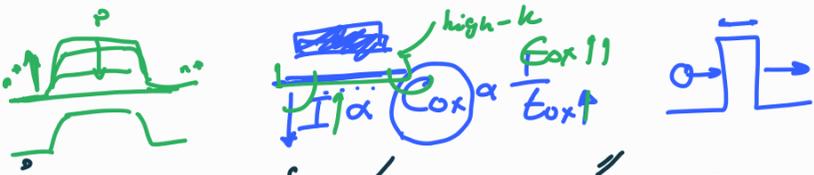


تمرین شماره ۱۱ - (+) انتخابی (sp) اسپایس

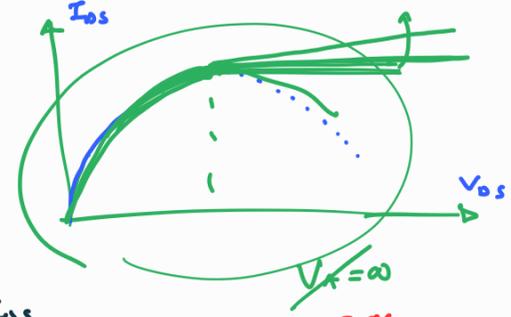
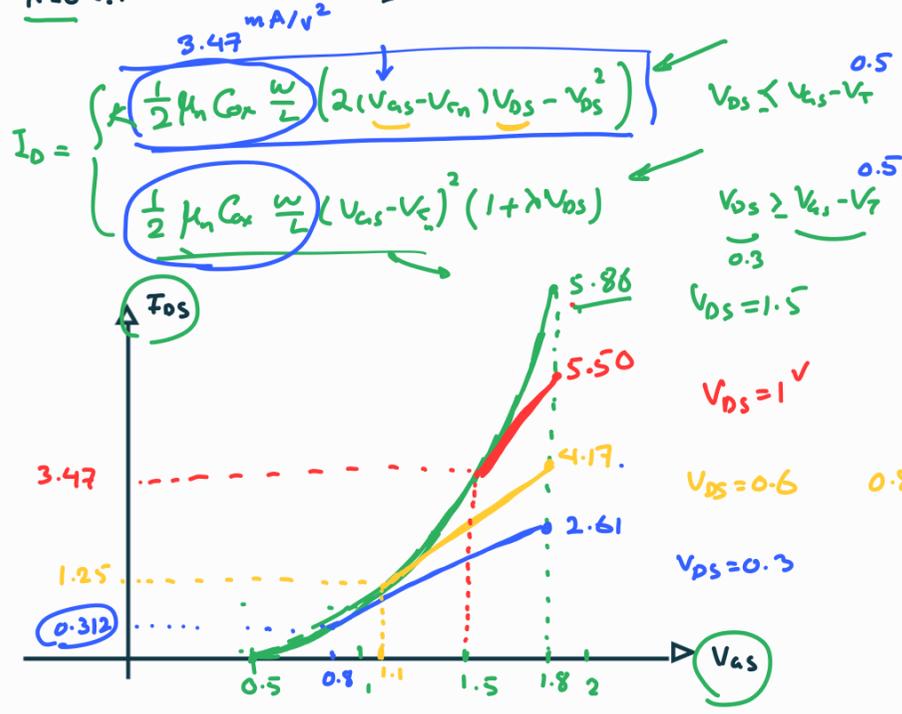


۱- دیگ برآزستید MOS توخ و حد حرکت از عوامل زیر چه تأثیری روی مشخصات برآزستید می‌گذارد: (الف) ضخامت اکسید زیاد شود. (ب) ناخالصی درون زیاد شود. (ج) عمق نواحی سوختن درون زیاد شود.



۲- برای برآزستید MOS در محدوده  $V_{as} = [0, 1.8]$  و  $V_{os} = \{0.3, 0.6, 1, 1.5\}$  منحنی  $I_D - V_{as}$  را رسم کنید. منحنی  $I_D - V_{os}$  را رسم کنید.  $V_{as} = \{0.3, 0.6, 1, 1.8\}$  و  $V_{os} = [0.9, 1.8]$  منحنی  $I_D - V_{os}$  را رسم کنید.

$$\begin{cases} \mu_n C_{ox} = 250 \text{ mA/V}^2 \\ \frac{W}{L} = \frac{5}{0.18} \\ V_{thn} = 0.5 \text{ V} \\ \lambda = 0 \text{ (!)} \end{cases}$$

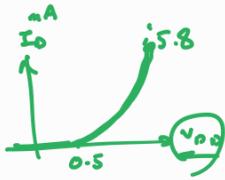


$$\frac{\partial I_D}{\partial V_{as}} = \begin{cases} K(2V_{os}) \checkmark \\ K(2(V_{as} - V_T)) \checkmark \end{cases} \quad V_{as} - V_T = V_{os}$$

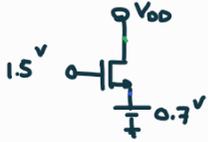
۳. در مدار زیر اگر  $V_{DD}$  از ۰ تا ۱.۸ تغییر کند یعنی  $I_D - V_{DD}$  را رسم کنید. (نسخه تراز شده با شماره ۲)



$V_{DS} > V_{GS} - V_T$



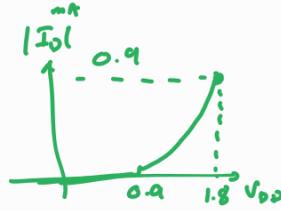
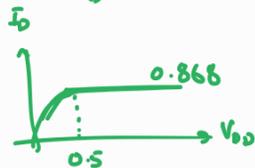
$V_{DS} = V_{DD}$   
 $V_{GS} = V_{DD}$



$V_{GS} = 0.8$   
 $V_{GS} - V_{th} = 0.3$



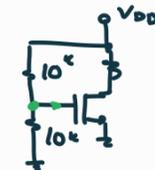
$V_{GS} = 1V$   
 $V_{GS} - V_T = 0.5$



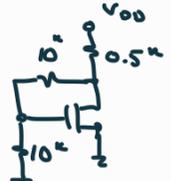
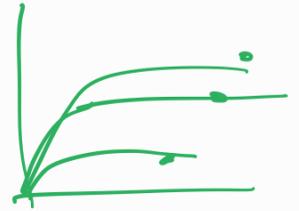
$|V_{GS}| = |0.4 - V_{DD}|$



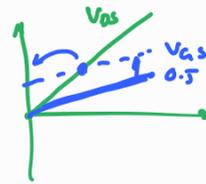
$\mu_p C_{ox} = 80 \mu A/V^2$   
 $V_{thp} = -0.5V$   
معیار  $\frac{W}{L}, \lambda$



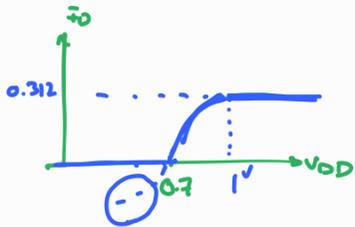
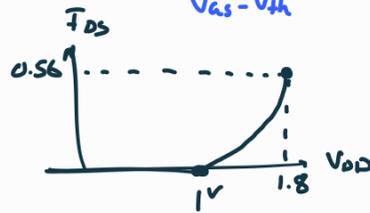
$V_{GS} = \frac{V_{DD}}{2}$   
 $V_{DS} = V_{DD}$



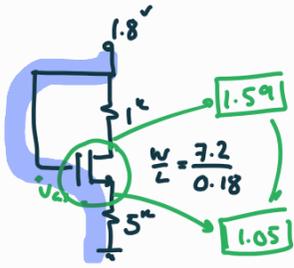
(\*)



$V_{GS} - V_{th}$



ع. مدل سفید لوحه ترانزیستورهای مدرن زیر را به دست آورید. (بقیه صفحات ترانزیستور مشابه قبل)

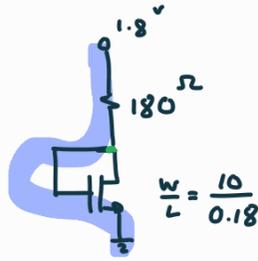


(\*)

$$\begin{cases} 1.8 = V_{GS} + 5i_D \\ i_D = 5(V_{GS} - 0.5)^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{GS} = 0.71V \\ i_D = 0.21mA \end{cases}$$

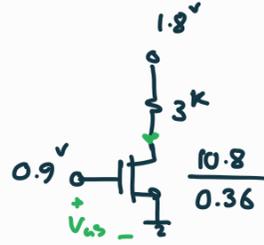
$$V_{DS} = 0.54V > V_{GS} - V_{th}$$



$$\begin{cases} 1.8 = V_{GS} + 0.18i_D \\ i_D = 6.94(V_{GS} - 0.5)^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{GS} = 1.19V \\ i_D = 3.36mA \end{cases}$$

$$g_{dm} = \frac{i_D}{\frac{V_{GS} - V_{th}}{2}} = 9.74 \text{ mS}$$

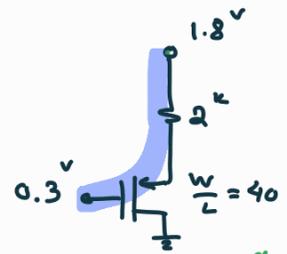


$$i_D = \frac{3.75(0.9 - 0.5)^2}{0.36} = 0.6 \text{ mA}$$

$$i_D = 3.75(0.8V_D - V_D^2)$$

$$V_D = 1.8 - 3i_D$$

$$\begin{cases} V_D = 0.25V \\ i_D = 0.51mA \end{cases}$$



$$|V_{GS}| + 2|i_D| = 1.8 - 0.3$$

$$|i_D| = 1.6(1.5 - 0.3)^2$$

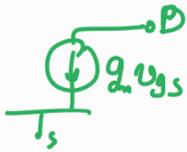
$$|V_{GS}| = 0.92V$$

$$|i_D| = 0.29mA$$

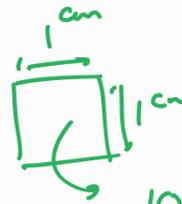
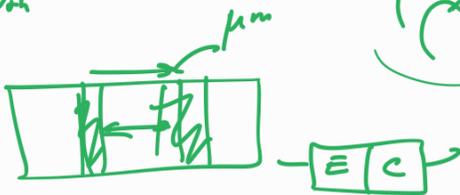


$$g_{dm} = \frac{2i_D}{V_{GS} - V_{th}} = 1.38 \text{ mS}$$

C<sub>gs</sub>



$$g_{dm} = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{th}} = 2 \text{ mS}$$



10 milliard